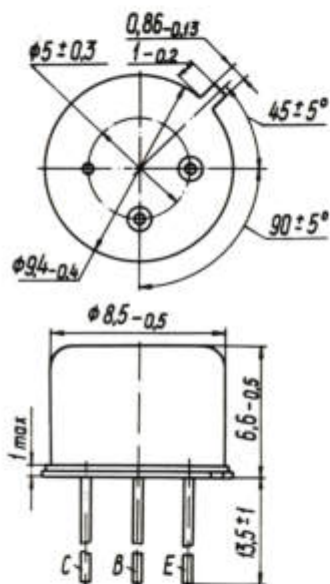


KT659A



СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
MEDIUM POWER HIGH FREQUENCY



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор KT659A предназначен для работы в переключающих схемах различных радиотехнических систем широкого применения.

Оформление - в металlostеклянном корпусе. Диапазон допустимых рабочих температур от -45 до +85°C.

GENERAL DESCRIPTION

The KT659A transistors are Silicon planar - epitaxial n-p-n transistors designed for use in switching circuits of radio equipment in a wide range of applications.

The devices are encapsulated in metal - glass cases.

Allowable operating temperatures: -45 to 85°C.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

$U_{EB \text{ max}}$	6 V
$U_{CB \text{ max}}$	60 V
$U_{CE \text{ max}}$ ($R_{BE} = 0$)	50 V
$I_C \text{ max}$	12 A
$P_C \text{ max}^*$ ($t_{amb} < 25^\circ\text{C}$)	1 W
$t_j \text{ max}$	180°C

*
При
At

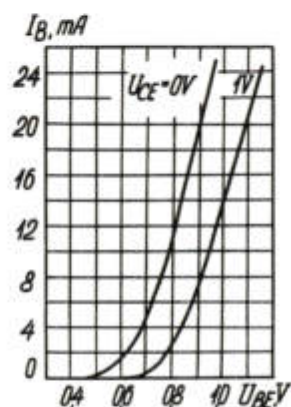
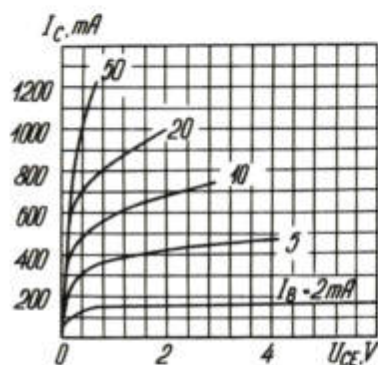


$$t_{amb} > 25^\circ\text{C} \Rightarrow P_C = \frac{180 - t_{amb}}{R_{tjha}}$$

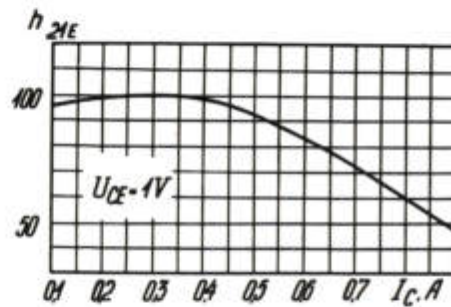
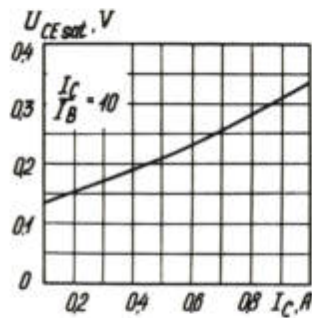
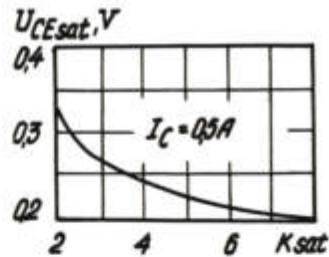
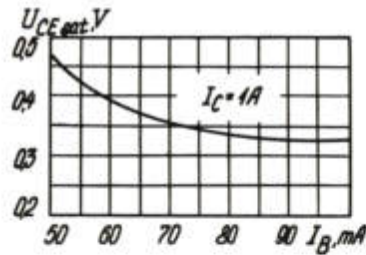
КТ659А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions		
		$U_{CE}; U_{CB}^*, V$	$I_C; I_B^*; I_E^{**}, mA$	f, MHz
$I_{CBO}, \mu A$	$< 0,5$	60^*		
$I_{EBO}, \mu A$	< 50	6^*		
$U_{CE sat}, V$	$< 0,9$		$1000; 100^*$	
h_{21E}	> 35	1	300	
$ h_{21E} $	> 3	10	100	100
C_C, pF	< 10	10^*	0^{**}	30
t_{on}, ns	< 40		$1000; 100^*$	
t_{off}, ns	< 80		$1000; 100^*$	



KT659A



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации транзистора рекомендуется учитывать возможность его самовозбуждения как высокочастотного элемента с большим коэффициентом усиления.

При включении транзисторов в схему, находящуюся под напряжением, базовый вывод должен присоединяться первым и отключаться последним.

Пайку выводов допускается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора. Время пайки не более 10 с, температура пайки не должна превышать $(260 \pm 5)^\circ C$.

OPERATING INSTRUCTIONS

Being a high frequency device with high gain the transistor must be protected from selfoscillating.

When the transistor is used in energized circuits its base lead is the first to be connected and the last to be disconnected.

Lead soldering is to be performed at a distance of $> 5 mm$ from the case. Soldering time and temperature must not exceed 10 s and $(260 \pm 5)^\circ C$, respectively.